

2SD1765

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコンダーリントランジスタ
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.
Epitaxial Planar NPN Silicon Darlington Transistor

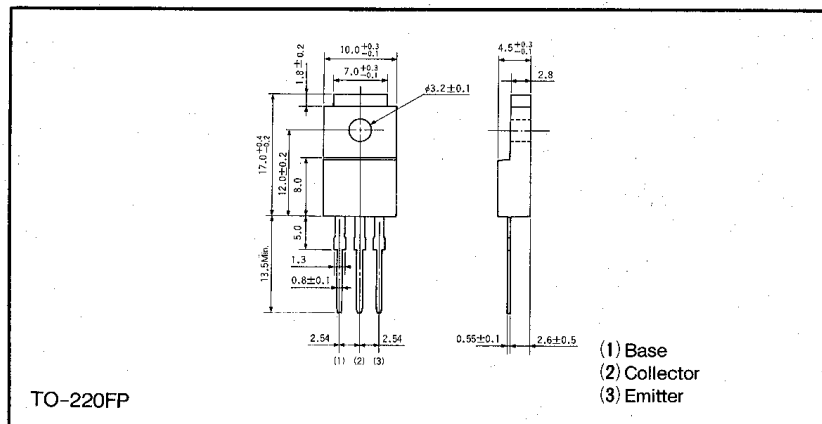
● 特長

- 1) ダンパダイオード内蔵。
- 2) ベース・エミッタ間に抵抗内蔵。
- 3) フィンをフルモールドで覆っているため、放熱板との絶縁が容易。

● Features

- 1) Damper diode is incorporation.
- 2) Built-in resistance between base and emitter.
- 3) Full-mold covered fin enables easy insulation from heat sink.

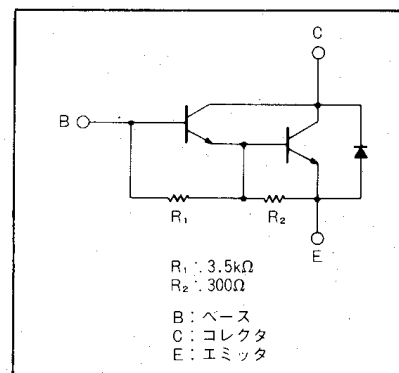
● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	100	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	2	A
		3	A(Pulse)
コレクタ損失	P_C	20	W(Tc=25°C)
		2	W(Ta=25°C)
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	°C

● 内部等価回路図



● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	100	—	—	V	$I_C = 5mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CB0}	100	—	—	V	$I_C = 50\mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	10	μA	$V_{CB} = 100V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	3	mA	$V_{EB} = 5V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.5	V	$I_C/I_B = 1A/1mA$
直流電流増幅率	h_{FE}	1000	—	10000	—	$V_{CE}/I_C = 2V/1A$
出力容量	C_{ob}	—	25	—	pF	$V_{CB} = 10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

● 標準品・準標準品一覧表 (◎:標準品 ○:準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	トレイ
		記号	Y2
		基本発注単位(個)	200
2SD1765	1K~10K		◎